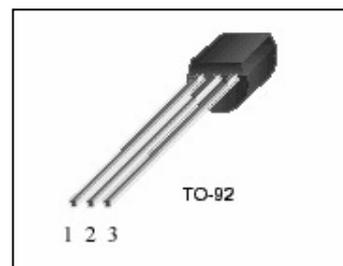


КТ645А,Б**PNP КРЕМНИЕВЫЙ ЭПИТАКСИАЛЬНО – ПЛАНАРНЫЙ
ТРАНЗИСТОР**аАО.336.333 ТУ

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАБОТЫ В АППАРАТУРЕ ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

- * Зарубежный аналог – BC547, BC238
- * Изготавливается в корпусе **КТ-26 (ТО-92)**.

**1 – Коллектор 2 – База 3 – Эмиттер****ПРЕДЕЛЬНО- ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Параметры		Обозначение	Ед. измер.	Значение
Напряжение коллектор-база	КТ645А	Uкб max	В	60
	КТ645Б			40
Напряжение коллектор-эмиттер	КТ645А	Uкэг max	В	50
	КТ645Б			40
Напряжение эмиттер-база	КТ645А	Uэб max	В	4
	КТ645Б			5
Постоянный ток коллектора		Iк max	мА	300
Импульсный ток коллектора (ti ≤ 10 мс, Q ≥ 5)		Iки max	мА	600
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора		Pк max	мВт	500
Импульсная рассеиваемая мощность коллектора		Pи max	мВт	1000
Температура перехода		Tп	°С	150

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (Токр.ср.=25°С)

Параметры	Обозначение	Ед. измер	Режимы измерения	Min	Max
Граничное напряжение коллектор - эмиттер КТ645Б	Uкэо гр.*	В	Iк= 10мА, Iб=0	30	
Обратный ток коллектора	Iкбо	мкА	Uкб=40 - 60В, Iэ=0		10
Статический коэффициент передачи тока КТ645А КТ645Б	h21E		Uкб=2В, Iэ=150мА	20	200
			Uкб=10В, Iэ=2мА	80	
Напряжение насыщения коллектор- эмиттер КТ645А КТ645Б	Uкэ(нас)	В	Iк=150мА, Iб=15мА		0,5
			Iк=10мА, Iб=1мА		0,05
Напряжение насыщения база - эмиттер	Uбэ(нас)*	В	Iк=150мА, Iб=15мА		1,2
Время рассасывания	КТ645А	трас	нс	Iб1=Iб2=15мА, Iк=150мА	50
Емкость коллекторного перехода	Ск	пФ	Uкб=10В, f=10МГц		5
Граничная частота коэффициента передачи тока	fгр *	МГц	Uкэ=10В, Iк=50мА	250	
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте	τк *	пс	Uкб=5В, Iэ=5мА, f=5МГц		120

* Справочные параметры